

## シリサイド系半導体 第8回夏の学校プログラム

7月24日(土)

受付 13:00 ~ 13:30

- 13:40 事務連絡 (館内案内と留意事項)
- 13:50 開会の挨拶
- 14:00 ~ 15:00 **講義 1 「Si 中の遷移金属とその複合欠陥」**  
佐道泰造(九州大学)
- 15:00 ~ 15:30 休憩 (チェックイン, 部屋割り 入室可能)
- 15:30 ~ 16:30 **講義 2 「バルク  $\text{-FeSi}_2$  結晶の形成」**  
山内 勇(大阪大学)
- 16:30 ~ 17:30 **講義 3 「スピンエレクトロニクスの現状と課題, 新材料への期待」**  
秋永広幸(産総研・ナノ機能合成プロジェクト)
- 17:30 ~ 18:30 休憩 (記念撮影), 入浴
- 18:30 ~ 20:20 懇親会
- 20:20 ~ 20:30 休憩, 移動
- 20:30 ~ 22:30 ナイトセッション  
**「オブエレ応用への基礎技術の開発について」**  
自由発表, 総合討論
- 22:30 ~ 23:30 応物研究会幹事会 (幹事のみ)

7月25日(日)

7:30 ~ 8:30 朝食

10:00 までにチェックアウト

**一般講演 1** 4件 (15分講演, 5分質疑応答)

座長: 鈴木基史(京都大学)

- 9:00 ~ 9:20 「PLD法と低温熱処理による球状多結晶 相の形成機構に対する検討」  
中村慎吾(東京都立科技大学 M)
- 9:20 ~ 9:40 「 $\text{Mg}_2\text{Si}$  薄膜の成長と評価」  
水由雄介(静岡大学 M)
- 9:40 ~ 10:00 「溶融塩法による  $\text{-FeSi}_2$  の成長と評価」  
大石琢也(静岡大学 M)
- 10:00 ~ 10:20 「Zn溶媒を用いた  $\text{-FeSi}_2$  溶液成長」  
青木雄太(茨城大学 M)

10:20 ~ 10:30 休 憩

**一般講演 2** 4件(15分講演,5分質疑応答)

座 長:鵜殿治彦(茨城大学)

10:30 ~ 10:50 「発光デバイス用  $\alpha$ -FeSi<sub>2</sub>結晶の成長と評価」

三品 明生(大阪大学 M)

10:50 ~ 11:10 「スパッタ法で作製した鉄シリサイドの磁気抵抗効果」

竹ノ下昌志(埼玉大学 M)

11:10 ~ 11:30 「Si/ $\alpha$ -FeSi<sub>2</sub>(粒)/Siの  $\alpha$ -FeSi<sub>2</sub>を多層化した構造の発光特性」

春原 剛(筑波大学 M)

11:30 ~ 11:50 「 $\alpha$ -FeSi<sub>2</sub>を活性層とするLEDの作製」

高氏 基喜(筑波大学 M)

11:50 ~ 13:00 昼 食

**一般講演 3** 2件(15分講演,5分質疑応答)

座 長:立岡浩一(静岡大学)

13:00 ~ 13:20 「Si基板上への三混晶系Ba<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>Si<sub>2</sub>薄膜のエピタキシャル成長」

猪俣裕哉(筑波大学)

13:20 ~ 13:40 「携帯電話からの貴金属のリサイクル」

高橋國彦(横浜金属、埼玉大)

13:40 ~ 14:40 **講義 4** 「CVD法での高品質FeSi<sub>2</sub>結晶薄膜の形成と物性評価」

秋山賢輔(神奈川産総研)

14:40 閉会のことば

事務連絡

現地解散

送迎バス: JR 能登川駅行き 15:20, 15:50 に出ます.